

2022年12月12日

各位

会社名 株式会社ジェイテックコーポレーション
代表者名 代表取締役社長 津村尚史
(コード番号：3446 東証プライム)
問合せ先 取締役 管理部長 平井靖人
(TEL. 072-655-2785)

SEMICON Japan 出展のお知らせ

当社は、2022年12月14日（水）から16日（金）にかけて東京ビッグサイト（東京都江東区）で開催される SEMICON Japan に出展し、下記の通り半導体向けの超精密加工技術や加工装置の紹介を行いますので、お知らせいたします。

記

1. 出展目的

当社は、大阪大学の独自の超精密加工技術である「Elastic Emission Machining (EEM)」、「触媒基準エッチング法 (CARE)」、「プラズマ化学気相加工法 (Plasma CVM)」、「プラズマ援用研磨法 (PAP)」の導入を図り、独自の半導体向け加工・研磨技術の開発及びそれら装置の実用化開発を進めております。

今回出展を行う SEMICON Japan は、半導体産業における製造技術、装置、材料をはじめ、車や IoT 機器などの SMART アプリケーションまでカバーするエレクトロニクス製造の国際展示会であり、多くのユーザーが来訪されます。

そこで当社では、既に実用化に成功している EEM 加工技術や納入実績のある Plasma CVM 加工技術の展開を図るため、また、複数の企業から引合いをいただいている CARE や PAP の超精密加工技術について本格的に広く認知、理解していただくため、SEMICON Japan においてこれら技術の紹介をいたします。

2. 出展内容

導入技術	出展内容
EEM	加工原理と加工データの紹介 加工サンプル：1 m 超高精度集光 X 線反射ミラー
CARE	加工原理と加工データの紹介 加工サンプル：水晶ウエハ、YAG 結晶
Plasma CVM	加工原理と加工データの紹介 加工サンプル：シリコンウエハ、SOI ウエハ
PAP	加工原理と加工データの紹介

本展示会においては、世界最高精度の表面を有する 1m サイズの X 線ミラーを始め、シリコンウエハ、SOI (Silicon-On-Insulator) ウエハ^{※1}、YAG (イットリウム・アルミニウム・ガーネット) ウエハ^{※2} など、各加工法によるサンプル加工物の展示がございます。また、パワーデバイス向けの SiC ウエハや GaN ウエハなどの半導体材料や、ニオブ酸リチウム^{※3} のような電子デバイス向けの各種結晶材料の適用加工事例についても紹介いたします。

- ※1 Si 基板の上に絶縁層である SiO₂ 層と Si 層が積層された構造を有するウエハ。半導体デバイスの動作速度向上と消費電力削減に効果があります。
- ※2 工業用レーザーの発振用媒質として有名。白色 LED にも使用され、今後広い用途展開が期待されています。
- ※3 表面弾性派素子やレーザー素子などの基板材料であり、多岐に渡る用途として注目されています。

以 上